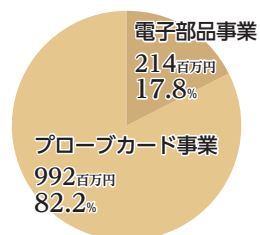


● セグメント別売上高構成比



事業年度 4月1日～翌年3月31日  
 定時株主総会 毎年6月  
 上記基準日 毎年3月31日  
 その他必要あるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。

配当金受領株主確定日 期末配当金 — 3月31日  
 中間配当金 — 9月30日  
 (中間配当を行う場合)

単元株式数 100株  
 公告掲載URL <http://www.tclab.co.jp>  
 (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に掲載いたします。)

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社  
 特別口座の口座管理機関

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
 〒137-8081  
 東京都江東区東砂七丁目10番11号  
 TEL 0120-232-711 (通話料無料)

上場金融商品取引所 大阪証券取引所 (JASDAQ市場)

(ご注意)

- 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式会社 東京カソード研究所  
 "MICRO TECHNOLOGY OF DISPLAY & SEMICONDUCTOR"  
 URL <http://www.tclab.co.jp>

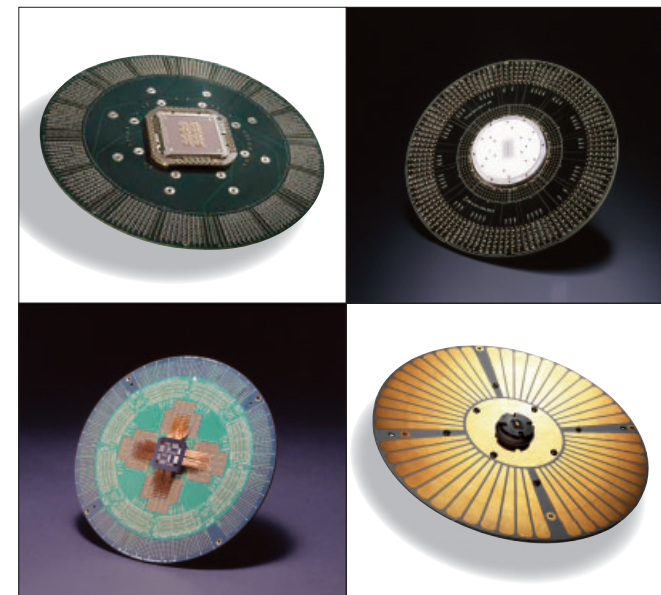


TCL TOKYO CATHODE LABORATORY  
 通信

AUTUMN 2010

2010年度 第1四半期  
 決算のご報告

2010.4.1-2010.6.30



※当社は、幅広い製品ラインナップでお客様のご要望にお応えしています。

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2011年3月期第1四半期が終了いたしましたので、ここにTCL通信2010年秋号をお届けいたします。

当第1四半期連結会計期間における電気・電子業界は、液晶・半導体関連の早期回復とアジア地域における購買層の増加により、デジタル家電を中心とした消費が大きく伸び、市場環境は着実に回復してまいりました。

このような状況のもと、当社グループは、プローブカードをコア事業とした事業再編計画を着々と実行に移し、選択と集中により構造改革を進めてまいりました。製造部門では、海外子会社の生産効率向上のための人材教育を推進することでコスト削減を目指した施策を進めております。開発部門では、既存製品の性能アップのために改良型を製品化し、また、新製品の今期市場投入に向けた開発強化を推進しております。営業部門では、グループ各社の連携を強めることにより取引先からの多様な需要に応えていく施策を進めております。

この結果、当第1四半期連結会計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成績につきましては、売上高は1,207百万円（前年同期比40.8%減）、営業利益は34百万円（前年同期は135百万円の営業損失）、経常利益は49百万円（前年同期は119百万円の経常損失）、四半期純利益は15百万円（前年同期は88百万円の四半期純損失）となりました。

今後も事業再編計画に基づき、より一層の向上を図ってまいりますので、ご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

大久保 尚武

Summary

## TCLの新たな挑戦

～当社が参加しているプロジェクトについて～

当社は、平成22年5月26日付でホームページにてご案内しましたとおり、独立行政法人産業技術総合研究所先端パワーエレクトロニクス研究センターとの共同研究において、パワー半導体向けシリコンカーバイド（SiC）の高効率マルチ切断技術の開発に成功しました。

また、本技術は、平成22年4月30日付で経済産業省が進める『低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト』に採択されました。

さらに、平成22年7月30日付で、当社が参加している当プロジェクトの実行団体である技術開発組合「次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構（FUPET：<http://www.fupet.or.jp>）」が経済産業省との間で正式に委託契約を締結したことにより、当プロジェクトは大きく前進し、その推進もより確かなものになりました。

経済産業省『低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト』の概要は次のとおりです。

### ●プロジェクトの事業期間

平成22年度から平成26年度までの5年間

### ●当社が参画する研究開発項目

全体共同提案のうち、「大口径SiCウエハ加工技術開発」について

### ●当社の委託内容

SiCのマルチ切断技術に係る研究開発業務

### ●プロジェクトの事業規模

平成22年度の事業予算はプロジェクト全体で1,999百万円であり、当社の費用は全て本予算より配賦されます。



※従来の複数枚切断技術に比べて、高効率、短時間、低コスト及び高品質で切断が可能となりました。写真は2インチ10枚（直径約50mm）の切断例です。

半導体には、電卓やパソコンのように演算を行ったり、メモリーカードのように情報を記録したり、液晶テレビの色彩をコントロールしたりと様々な種類がありますが、この中には家電製品の電力を制御したり変換したりする半導体があり、これをパワー半導体と呼んでいます。

パワー半導体は、家電製品の省エネ化や、電気自動車の性能向上、スマートグリッド構想における電力の発電や制御など、地球温暖化防止の鍵を握る重要な半導体ともいわれており、化石エネルギーから電気エネルギーへと技術が移行する中で今後ますます需要が増すことが予想されています。

このパワー半導体の素材として期待が高まっているのが、シリコンカーバイド（SiC）のウエハです。シリコンカーバイド（SiC）のウエハは、現在多種多様な機器に使われているシリコンウエハより熱に強く、電力の損失が少ないため、シリコンウエハが物理的に限界となる大電流や高周波を伴うパワー半導体の素材として生産増強が期待されています。

以前から、このシリコンカーバイド（SiC）の結晶体はダイヤモンドに次ぐ難加工性を有することから、製造過程で様々な技術的課題がありました。特に結晶体をウエハにするための切断工程においては、砥粒方式（とりゅうほうしき：研磨用の高硬度粒子）マルチワイヤーソーを用いた複数枚切断が通常の方法として採用されていますが、時間、コスト、品質等さらなる高効率化の要求が高まっていました。その中、当社は、放電加工技術を応用すると同時に、電子部品事業において培ってきた電子銃技術を基に独自開発したマルチ切断技術（複数枚同時切断技術）を開発し、高速かつ高効率でシリコンカーバイド（SiC）単結晶からウエハを同時に複数枚切り出すことに成功いたしました。

この技術については、興味を持たれた複数の会社からすでに問合せもあり、業界における当社の技術力の高さが改めて評価され注目されております。当社は、プローブカード事業をコアにした事業再編計画を進めながらも、常に新しい挑戦を続けることで技術の幅をより大きくし、社会に貢献していきます。